

уши

-10-

Сов. секретно

Экз. 4

Председателю Государственного Комитета  
Совета Министров СССР по радиоэлек-  
тронике

тов. Калмыкову В. Д.

Зам. Председателя Государственного Комитета  
Совета Министров СССР по радиоэлектронике

тов. Шокину А. И.

Начальнику 12 Управления ГКРЭ тов. Пасьяцкому И. Ф.

Докладываю, что в городе Риге, может быть высвобождено ряд казарменных помещений, которые без сравнительно больших затрат и в короткие сроки могут быть переоборудованы под полупроводниковое производство.

Два главных четырехэтажных корпуса упомянутых помеще-  
ний с общей площадью более тринадцати тысяч кв. метров и  
кубатурой около 50 тысяч кубометров, имеют достаточно проч-  
ные ж. б. междуэтажные перекрытия, широкие корридоры и лест-  
ницы, большие связанные друг с другом комнаты и зала площа-  
дью по 200-300 кв. метров и хорошо оборудованную приточно-  
вытяжную вентиляцию.

Кроме того здесь же имеются несколько кирпичных одно-  
этажных отапливаемых помещений (столовая, гаражи, склады) с  
общей площадью свыше 3000 кв. метров и несколько кирпичных  
не отапливаемых помещений с общей площадью около 2000 кв.  
метров, центральная котельная и электроподстанция, которые мо-  
гут быть легко приспособлены под вспомогательные службы по-  
лупроводникового производства.

Перечисленные помещения расположены на окраине города  
Риги (ул. Гауяс дом № 17/19) рядом с зеленой зоной межапар-  
ка и кладбищем Райниса, занимая ок. 8,5 гектаров огороженной  
кирпичным забором организованной территории на которой в  
дальнейшем можно разместить 8-10 новых типовых многоэтажных  
герметизованных корпусов для полупроводникового производства  
по типу разработанных ГСНН-5, с общей площадью производствен-  
ных помещений до 40-50 тысяч кв. метров.

-115

В настоящее все упомянутые помещения и территория находится в распоряжении воинской части 7458 войск МВД СССР, которая может быть успешно и быстро размещена в других свободных казарменных помещениях г. Риги.

В целях ускорения развития полупроводникового производства в Латвийской ССР, исключительно целесообразно уже в этом году передать указанные помещения Рижскому заводу полупроводниковых приборов № 390, в связи с чем прошу Вашего указания соответствующим управлениям и отделам ГКРЭ возбудить по этому вопросу нужные мотивированные ходатайства перед Министром внутренних дел СССР т. Дудоровым Н. П. и Министром обороны СССР тов. Малиновским Р. Я.

При должной организации дела, в упомянутых казарменных помещениях возможно в течении одного года развернуть массовое производство полупроводниковых приборов в количестве до 30 миллионов штук в год.

Кроме того, за счет дальнейшего строительства соответствующего числа новых типовых корпусов на имеющихся тут же свободных площадях, вполне реально создание в городе Риге в течении двух ближайших лет (с учетом строящейся первой очереди з-да № 390 на отведенной территории по ул. Ронаку 140) мощного электронного центра для производства полупроводниковых приборов, электронных блоков и микромодулей с использованием самой современной высокомеханизированной и автоматизированной технологии с соответствующей лабораторной и экспериментальной базой, на производственную мощность Рижского электронного центра до 100 миллионов единиц высококачественных приборов в год, с общей годовой стоимостью выпускаемой продукции свыше одного миллиарда рублей.

Учитывая исключительную заинтересованность Министерства обороны СССР в ускорении развития полупроводникового производства полагаю, что тов. Дудоров Н. П. и тов. Малиновский Р. Я. решат затронутый вопрос положительно.

Директор Рижского з-да  
полупроводниковых приборов № 390

(С. Бергман)

*Верно: С. Бергман*